① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-43396

@Int.Cl.4

識別記号

广内整理番号

四公開 昭和63年(1988)2月24日

H 05 K 3/46

E-7342-5F N-7342-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称		配線板の製造方法	
		O 1.1	昭61-188018 昭61(1986) 8月11日
⑦発 明	者	坪 松 良 明	茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 館研究所内
70発 型	者	福富直街	茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 館研究所内
砂発 リ	1 者	木 田 明 成	茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 館研究所内
· ⑦発 リ	者	安 岡 択 也	茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 館工場内
砂出 即	人	日立化成工業株式会社	東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
②代 理	图 人	弁理士 废類 章	

男 超 警

1. 発明の名称 :

配線板の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 次の各工程からなる配線板の製造方法。
 - 州 基板上の所望部分に所望呼さのめっきレ ツストを形成する。
 - (P) 該めっきレジスト以外の部分にめっき金 級のポストを形成する。
 - 17 飲めっきレジストを除去する。
 - (3) 第1 絶縁層として機脂を所望厚さに強減して熱硬化させ研集してポスト頻頂部を終出させる。
 - (対 第2般練僧として樹脂を所望厚さに強度 砂、直径が設ポスト頭頂部より小さくかつ 梁さが頭頂部に連する穴を加工する。
 - (*) 全面に金銭層を設け、さらにエッチング によって所望の回路パターンを形成する。
- 3. 発明の詳細な説明

(確梁上の利用分野)

本発明は、配線板の製造方法に係るものであり、特に高密度配線が可能な傾間接続方法に関する。

(従来の技術)

従来、高密度配線を有する配線板は、信号伝送の高速化をはかるため、信号の遅延が少ない 低誘電率材料(例えば誘氓率が3~35である ポリイミド側脂)を絶縁層として使い、腐間接続は小径パイアホール或るいはスルーホールポストなどにより行った。

(発明が解決しようとする問題点)

 受であり、スループットが恐しく低下してしま う。

本発明者は、以上のような従来の周間接続方法の問題点にかんがみ、彼々考疑研究の結果、 本発明を完成するに至った。

本発明は、層間接続にスルーホールポストと バイナホールを併用する。すなわち、従来のレ ジスト形成及びめっき方法で容易に形成できる

し、窒果気流中で350℃、40分間加熱して 第1絶録暦5を得た。 この第1絶録層袋面を研 率してスルーホールポスト4の類頂部を路出さ せ(H2=40μm)、さらに感光性ポリイミトR しー1100(日立化成社製)を1回塗布をひ がイアホール7を形成した。 次にスパッタリング 変置 M L H ー 6 3 1 5 D (日本真に観いて を用いて、以下に示す条件でクロムに観いて動 をパイプホール7の内 を用いて、以下に示す条件でクロムに緩いて動 をパイプホール7の内 をパイプホール7の内 をのまるらにエッテングによっている。 でのようりとした。 スペッタリングのにエッテングによっているのになった。 でのないた。 スペッタリングのにエッテングによって必要にない。 ののでは、出力 1.5 kg、 高板加熱 1 2 0 で4 5 分、圧力 5 × 1 0⁻⁸ torr、アルゴンガス の係3 5 S C C Mである。

. 以上の工程を数回機返して、多層配線を形成 してもよい。

前記アルミナ遊板に代えて、網接積階板、片 両銅箔付きポリイミドフィルムの所置部分をエ ッチングして導体パターンを形成したもの、ア 程度のアスペクト比を持ったスルーホールポストを形成した後、ポリイミド側脂等を強災する。 さらに無硬化した後、研摩等によってスルーホールポスト頭頂部を築出させ第2の側脂を繁災して、スルーホールポスト頭頂部面横より小さい径のパイアホールをエッチング加工する。 象無例

ルミナ系セラミック、P Z 系セラミック、フェルステライトなどの番板に無電解めっきによりパターン形成したもの、更に竣工程で餘去可能な保持体上にめっき等でパターン形成したものを使うことができる。

又、前記第1,2 総級層に用いたポリイミド 条樹脂に代えて、ファ柔樹脂、不飽和ポリエス テル樹脂を使用可能である。

(作用)

第1 絶縁隔5の厚さ(第1 図(d) Ha) は形成したスルーホールポスト4の高さHa と研摩の 想度によって調整できる。また、パイアホール 7 の上部径は、第2 絶縁廢6 の厚さによって敏 細化できる。との場合、全体の絶縁層厚さのう ち殆どを第1 絶縁層で占めることができるため、 第2 絶縁層は薄膜化可能である。更に、 第2 絶 録層6の種類を選定選択することで、 後工程の 金属配線及び第3 絶縁層との接着性を向上させ ることもできる。なお、 A面(第1 図(d)に示す) での高密度化は、 スルーホールポスト 頃頂節

特開昭63-43396(3)

よりも小径のパイアホール 7 を形成することで 達成できる。

(発明の効果)

本発明による顧問接続还は以上のような構成 によりなるものであり、配設の高密度化を達成 しつつ、低勤電材料からなる絶縁層の厚さを従 来以上に厚く形成可能となった。

また、スルーホールポストを研録で認出させる際、平坦化が困難であったが、第2 絶缺層を 形成することで容易に解決でき、後工程のパメ ーン形成時の信頼性が大幅に向上した。

以上のととから、本発明にかかる層間接続方 法は褒めて産業上価値の高いものである。

4、 図面の簡単な説明

第1図(a)~前は、本発明の方法を示す断面図 である。

- 1 足級基板
- 2 バターン
- 3 めっきレジスト 4 スルーホールポス
- S SF 1 SA HA HA
- 6 期 2 絶縁層
- 7 小径パイアホール 8 パダーン

代理人弁理士 资 淑 章







